

Rosen, Kantrow & Dillon, PLLC
Attorneys for Allan B. Mendelsohn, Trustee
38 New Street
Huntington, New York 11743
631 423 8527
Fred S. Kantrow
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

RETRUN DATE: 4/30/18
TIME: 9:30 a.m.

-----X
In re:

QUEST VENTURES, LTD.,

Case No.: 15-75499-reg
Chapter 7

Debtor.

-----X

**NOTICE OF TRUSTEE'S APPLICATION SEEKING ENTRY OF AN ORDER UNDER
SECTIONS 363(a), 363(b), 363(f) and 363(m) OF THE BANKRUPTCY
CODE AND RULES 2002, 6004 AND 9004 OF THE FEDERAL RULES OF
BANKRUPTCY PROCEDURE: (1) AUTHORIZING TRUSTEE TO SELL
TO IPA ASSET MANAGEMENT IV, LLC OR ITS DESIGNEE (the "STALKING
HORSE"), OR THE HIGHEST AND BEST BIDDER AT AN AUCTION SALE
ESTATE'S INTEREST IN THE REAL PROPERTY COMMONLY KNOWN AS
3581 MIDDLE COUNTRY ROAD, CALVERTON, NEW YORK AND
3605 MIDDLE COUNTRY ROAD, CALVERTON, NEW YORK;
(2) SCHEDULING A HEARING TO APPROVE SUCH SALE TO THE STALKING
HORSE OR THE HIGHEST AND BEST BIDDER; (3) APPROVING CERTAIN
BIDDING PROCEDURES; AND (4) APPROVING THE MANNER AND EXTENT OF
NOTICE OF SUCH AUCTION HEARING**

PLEASE TAKE NOTICE that Allan B. Mendelsohn, trustee (the "Trustee") of the estate of Quest Ventures, Ltd. the debtor (the "Debtor"), by and through his counsel, Rosen, Kantrow & Dillon, PLLC, shall move before the Hon. Robert E. Grossman, United States Bankruptcy Judge, on **APRIL 30, 2018 at 9:30 a.m.** or as soon thereafter as counsel may be heard, for the entry of an Order: (1) authorizing the Trustee to sell to IPA Management IV, LLC, or its designee (the "Stalking Horse") or to the highest and best bidder at an auction sale, the estate's interest in the real property commonly known as 3581 Middle Country Road, Calverton, New York (the "Undisputed Property") and/or the real property commonly known as 3605 Middle Country Road, Calverton, New York (the "Disputed Property"); (2) scheduling a hearing

to approve such sale to the Stalking Horse or the highest and best bidder; (3) approving certain bidding procedures; and (4) approving the manner and extent of notice of such auction hearing, at the United States Bankruptcy Court, 290 Federal Plaza, Central Islip, New York 11722 in Courtroom 860.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that objections, if any, to the relief sought in the Application must conform to the Federal Rules of Bankruptcy Procedure and the Local Rules of the Bankruptcy Court, as modified by any administrative orders entered in this case, and be filed with the Bankruptcy Court electronically in accordance with any Administrative Order of the Court, by registered users of the Bankruptcy Court's case filing system and, by all other parties in interest, on a 3.5 inch disk, preferably in Portable Document Format (PDF), WordPerfect, Microsoft Word, DOS text (ASCII) or a scanned image of the filing, with a hard copy delivered directly to Chambers, and be served in accordance with any Administrative Order of the Court, and upon: (i) Rosen, Kantrow & Dillon, PLLC, 38 New Street, Huntington, New York 11743; and (ii) the Office of the United States Trustee, 560 Federal Plaza, Central Islip, New York 11722; so as to be received by no later than 4:00 p.m. on April 23, 2018.

PLEASE TAKE FURTHER NOTICE that only timely objections may be considered by the Court.

Dated: Huntington, New York
March 30, 2018

Rosen, Kantrow & Dillon, PLLC
Attorneys for Allan B. Mendelsohn

BY: S/Fred S. Kantrow
Fred S. Kantrow
38 New Street
Huntington, New York 11743
631 423 8527
Fkantrow@rkdlawfirm.com

6 から構成されている。そして同図 (b) に示すように、センサ部 5 は 4 つの歪ゲージ 3 のパターン R₁ ~ R₄ とこれらに給電するための 6 つの電極 4 の配線パターン E₁ ~ E₆ とから構成されている。このセンサ部 5 を等価回路で示すと、同図 (c) に示すように、ブリッジ回路を構成しており、圧力に起因した歪による歪ゲージ 3 の抵抗変化によって生じる電極配線パターン E₁ と E₄ との間の電圧変化を検出することにより、圧力を測定するようになっている。

ところで、半導体素子には、特性の温度依存性が大きいという欠点がある。しかし温度に対する繰り返し再現性は優れており、補償後はこの特性が逆に素子の信頼性を高める結果になっている。半導体薄膜圧力センサの場合、歪ゲージの抵抗値は該歪ゲージの固有の抵抗値と、圧力による抵抗の変化とともに、温度で変化する。従って歪ゲージを組みあわせたブリッジ回路では、圧力感度と零点とが、ともに温度によって変化してしまう。温度補償をいかに上手に行うかで圧力センサの精

(b) に示すように、トランジスタを介してセンサ部に印加される電圧が高くなっていく (口)。センサ部に印加される電圧が高くなると温度によるセンサ部の感度低下分と相殺され、結果温度が上昇しても一定な感度を保つことができる (第 8 図 (a) (口))。このように温度補償用の素子を組み込んだ薄膜圧力センサは温度によって感度が変化しない信頼性の高いものとなる。

このような温度補償用の素子は、第 9 図に示すように薄膜圧力センサの外部に組み込まれている。薄膜圧力センサ 100 はケース 101 に組み込まれ、そのケース 101 と共に外部回路用のケース 102 に組み込まれる。同ケース 102 の内部にはアンプ 105 と温度補償用素子 106 が接続されたプリント基板 104 があり、同ケース 102 は蓋 103 によって閉じられている。プリント基板 104 上の温度補償用素子 106 によって温度補償された薄膜圧力センサ 100 の出力は、アンプ 105 によって増幅され、外部回路 (図示せず) に出力される。

度が決まるために、従来から種々様々な方法が試みられてきた。

次に示す方法は、定電圧駆動する圧力センサにおいて、トランジスタと抵抗を組み合わせて歪ゲージの感度の温度変動を相殺するものである。

第 7 図に温度補償用回路 7 を組み込んだ圧力センサの等価回路図を示すが、電極配線パターン E₁ ~ E₆ の接点と E₁ との間に、トランジスタ T₁ と抵抗 R₁ ~ R₄ とを接続する。

薄膜圧力センサの感度は、第 8 図 (a) に示すように、温度が高くなるにつれて直線的に低下してしまう (イ)。ここで感度とは、圧力センサが受ける圧力の大きさと、それによって生じる抵抗値の変化率である。つまり、

$$\text{感度} = \frac{\Delta (\text{抵抗値})}{\Delta (\text{圧力})}$$

となり、感度が高い方が精度が向上する。

いっぽう、温度補償に用いられているトランジスタの電圧降下は、温度が高くなるにつれて低くなる。つまり入力電圧を一定にしておけば第 8 図

また、従来はセンサモジュールを圧力変換器や他の被測定体に組み込む際、センサモジュールを拘束する位置は受圧面とほぼ同一面上にあった (第 5 図 (b))。

(発明が解決しようとする課題)

上記で説明した温度補償用の回路において、使用しているトランジスタの温度による電圧降下の変化率と、歪ゲージの温度による感度低下の変化率とは必ずしも一致しない。そこで、抵抗素子 R₁ ~ R₄ を 2 個用いて、その抵抗素子の 2 個の抵抗の比を変えることにより、前記電圧降下の温度依存性の値を自由に変えることができるので、歪ゲージの感度低下の変化率と一致させて、精度良く感度補正を行う。

従来この抵抗素子は、薄膜圧力センサの外部のプリント基板 104 に接続されていた。薄膜圧力センサは大変小さいので、プリント基板 104 にトランジスタとさらに抵抗素子 2 個をハンダ付けで接続したり、圧力センサの電極と接続したりするの困難であった。そして、抵抗素子 2 個を接

続するために、部品点数と工程が増えるということは、工程上の歩留り低下の要因、部品の不良や部品の接触不良等による歩留り低下の要因が大きく増えるということであった。

又、圧力センサを拘束し圧力を印加すると、拘束箇所の形状が変化し、第5図(c)に示すように拘束位置がずれる。従来のように拘束部が受圧面に近いと少しの拘束位置のずれでもダイヤフラム上の応力分布が大きく変化する(第5図(b))。この結果圧力に対する出力特性の直線性に影響を及ぼすという問題があった。

(課題を解決するための手段及び作用)

(1) 薄膜圧力センサの温度補償のための抵抗は、抵抗素子を用いて構成するのではなく、該薄膜圧力センサの歪ゲージを構成している材料を用いる。つまり、歪ゲージを形成する際、多結晶シリコン薄膜等を積層し、そしてパターニングを行うが、それと同時に、抵抗もパターニングして設ける。センサ部と抵抗との配線も、センサ部の電極配線パターンと同材料で同時に形成する。

E_+ の接点と印加電圧源 V_{in} (図示せず)との間に形成する。

第1図(b)に示すように、この実施例において薄膜圧力センサは、ステンレス1上に絶縁膜として SiO_2 膜2を積層し、次に歪ゲージ3と抵抗 R_1 、 R_2 とを多結晶シリコン薄膜で形成し、その上に電極4の配線パターン(E_+ 、 E_-)が形成されて構成されている。トランジスタ T は、 E_+ 、 E_- 間と、 E_+ 、 E_- とに外付けで接続される(図示せず)。この薄膜圧力センサの等価回路は第7図と同様である。

第2図(a)～(e)に本発明の第一の実施例の工程図を示し、説明する。

(1) 第2図(a)に示すように、ステンレスのダイヤフラム1上に、絶縁膜として SiO_2 膜をアラズマCVD法で約7μm積層する。

(2) 第2図(b)に示すように、該 SiO_2 膜上に多結晶シリコン薄膜をアラズマCVD法でシリカガスを原料に用いて約0.5μm積層する。

(3) 第2図(c)に示すように、積層した多結

抵抗部を形成した多結晶シリコン薄膜等は、形状を任意にかえることにより、所望の抵抗値を得ることができ、従って、抵抗素子を用いることなく、トランジスタの電圧降下の温度依存性の値を歪ゲージの感度低下の変化率と一致させることができる。

(2) ダイヤフラム受圧面の裏側に絶縁膜を介して歪ゲージを設けている薄膜圧力センサにおいて、ダイヤフラムの拘束面とダイヤフラム受圧面とに段差を設けた、つまり拘束面を受圧面から遠ざけることにより、圧力印加時の拘束位置変化による影響が及ばなくなる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に従って説明する。始めに補償用抵抗に関して説明する。

第1実施例

第1図に本発明の第一の実施例の(a)平面図と、(b)断面図を示す。第1図(a)に示すように、ダイヤフラム1の歪ゲージ3(R_1 、 R_2)の形成面に、抵抗 R_1 、 R_2 を、電極配線 E_+ 、 E_-

シリコン薄膜を、フォトリングラフィ工程を用いて、歪ゲージ3パターン(R_1 、 R_2)と抵抗パターン(R_1 、 R_2)を形成する。この時、抵抗パターンの形をかえることにより、所望の抵抗値が得られ、補償用回路のトランジスタの温度依存性の値を変えることができる。

尚、この抵抗パターン(R_1 、 R_2)は、歪を生じると抵抗値が変化してしまうので、一定の値を保つため、圧力によって歪を生じないダイヤフラムの周辺の位置に形成しなくてはならない。

(4) 第2図(d)に示すように、歪ゲージ(R_1 、 R_2)と抵抗(R_1 、 R_2)を形成した上に、アルミニウム(Al)等の金属電極4を蒸着し、フォトリングラフィ工程により配線パターン(E_+ 、 E_-)を形成し、配線する。

(5) 第2図(e)に示すように、歪ゲージ、抵抗、配線パターンを保護するために、バッシャーション膜として SiN_4 膜をアラズマCVD法で5000Å程度積層する。

以上で、薄膜圧力センサは完成する。そして、

この薄膜圧力センサは第9図に示したと同様に、ケース101に組み込まれ、そのケース101と共に外部回路用のケース102に組み込まれる。同ケース102の内部にはアンプ105と温度補償用のトランジスタが接続されたプリント基板104があり、同ケース102は蓋103によって閉じられる。プリント基板104上のトランジスタと、薄膜圧力センサの電極E₊～E₋間、E₊、E₋はボンディングワイヤ(図示せず)等で接続され、温度補償用回路は完成し、圧力センサの出力はアンプ105によって増幅され、外部回路(図示せず)に出力される。

このような構成の薄膜圧力センサにすることにより、温度補償用回路を構成する場合、部品、工程を増やすことなく、抵抗が形成できる。

本実施例は、感度に対する温度補償用の回路について説明したが、これに限ることなく、例えば零点に対する温度補償用の回路、各センサ間のバラツキによる零点補償用の回路等にも適用可能である。

第4図は本発明の第3の実施例の(a)平面図と(b)断面図である。温度補償素子を外部接続した場合の等価回路図は第2の実施例と同様(第3図(c))である。本実施例では第4図(a)に示すようにセンサ3(R₊～R₋)は実質長尺バターンなので抵抗が高く、これに伴って零点補償用抵抗R₀も高抵抗化する。従って本発明の第2の実施例のように、零点補償抵抗をくの字形などの実質幅広バターンにする必要はない。

又、本実施例では零点補償用粗調抵抗R₀をダイヤフラム1の中心に対して同一円周上に配置したので、感圧層成膜時の膜厚分布(ダイヤフラム中心が最も厚く外側に向かって薄くなる)を無視できる。そのため、複数個に区切られた粗調抵抗1個当たりの抵抗値のバラツキを低減でき、精度の良い補償ができる。

尚、本実施例では第4図(b)に示すように絶縁層2はS10₁一層であるが、ステンレスダイヤフラム1と絶縁層2の間に両者の線膨張係数の差を緩和するためのバッファ層として中間の線膨

第2実施例

第3図に第2の実施例として、感度に対する温度補償用の回路の抵抗R₊、R₋と、各センサ間のバラツキによる零点補償用抵抗R₀を、薄膜圧力センサのダイヤフラム上に形成した実施例の(a)平面図と(b)断面図と(c)温度補償素子としてトランジスタを外部接続した場合の等価回路図を示す。ダイヤフラム1上に、絶縁膜を積層し(図示せず)、その上にセンサ(R₊～R₋)と、感度に対する温度補償用の抵抗R₊、R₋と各センサ間のバラツキによる零点補償用回路の抵抗R₀として、多結晶シリコンを積層し、バーニングする。そしてA₁などの金属を積層しバーニングして、電極配線(E₊～E₋)を形成し、バッセーション膜(図示せず)を積層して薄膜圧力センサは完成する。本実施例ではE₊とE₋を結線し、その接点とE₀の電極から電圧を出力させることにより、R₀に零点粗調抵抗2個を、R₊に零点微調抵抗を加えたことになる。

第3実施例

張系数を持つ膜(例えばノンドープ多結晶シリコン膜0.3μm程度)を積層してもよい。

第4実施例

次に圧力センサの出力特性の直線性の改善に関して説明する。

第5図に圧力センサのダイヤフラム上の応力分布の拘束位置依存性を、(a)本発明によるダイヤフラム、(b)従来のダイヤフラム、について各々示している。

第5図(b)は従来のダイヤフラムの断面形状であり、拘束位置1aとダイヤフラム受圧部1bはほぼ同じ高さにあり、拘束部が①、②、③、④と少しその位置がずれることにより応力分布が大きく変わることを示し、第5図(a)は本発明のダイヤフラムの断面形状であり、拘束位置1aとダイヤフラム受圧部1bには段差が設けてあり、拘束位置1aとダイヤフラム受圧部1bは離れている。本発明の構造であると、拘束部が①、②とその位置がずれても応力分布に変化はない。

従って、圧力印加時、第5図(c)に示すよう

に拘束位置がずれても、拘束部が受圧部に悪影響を及ぼさないので直線性は大幅に改善される。実施例では非直線性は約1/3に低減された(第5図(d))。

(発明の効果)

本発明の特許請求の範囲第1項の発明によれば補償用回路の抵抗をダイヤフラム上に歪ゲージと同材料で形成しているので、抵抗素子の部品点数を増やすことなく、また、ハンダ付等の工程数を増やすことなく、補償用回路の抵抗を構成することができる。そのため、ハンダ付等の工程中におこる不良、接触不良等による歩留り低下などの要因がなくなるため、歩留りは向上する。さらに、抵抗は歪ゲージと同材料で、同工程で形成されるので、薄膜圧力センサの工程を変えることなく、抵抗を形成することができるので、抵抗を形成することによっての工程の時間数は全く増加しない。

本発明の特許請求の範囲第2項の発明によれば圧力印加時に拘束位置がずれても、ダイヤフラムの応力分布に変化がなくなり、圧力センサの出力

特性の直線性が向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明第1の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図

第2図は同工程図

第3図は本発明第2の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図(c)等価回路図

第4図は本発明の第3の実施例の薄膜圧力センサの(a)平面図と(b)断面図

第5図(a)は本発明による薄膜圧力センサのダイヤフラムの応力分布の拘束位置依存性を示すグラフ、第5図(b)は従来の薄膜圧力センサのダイヤフラムの応力分布の拘束位置依存性を示すグラフ、第5図(c)は圧力印加時のダイヤフラム拘束位置のずれを表す図、第5図(d)は本発明による直線性の改善を示すグラフである。

第6図は従来の薄膜圧力センサの(a)断面図と(b)平面図と(c)等価回路図

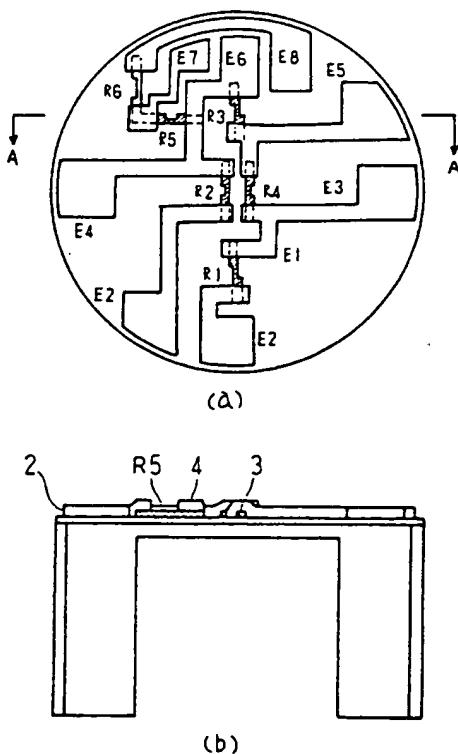
第7図は補償用回路を組み込んだ薄膜圧力センサの等価回路図

第8図(a)は薄膜圧力センサの感度と温度の関係を示す図、第8図(b)は温度補償用素子を介してセンサ部に印加される電圧と温度との関係を示す図

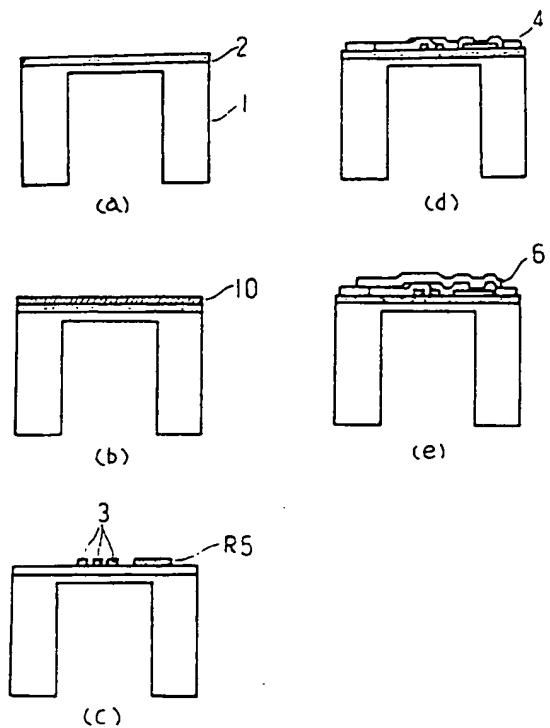
第9図は薄膜圧力センサと回路等をケースに組み込んだ図である。

- 1 ··· ダイヤフラム 4 ··· 電極
- 1a ··· 拘束位置
- 1b ··· ダイヤフラム受圧部
- 2 ··· 絶縁膜 5 ··· センサ部
- 3 ··· 歪ゲージ
- 6 ··· バッシャーション膜
- 7 ··· 温度補償用回路
- 87 ··· 零点補償用の抵抗

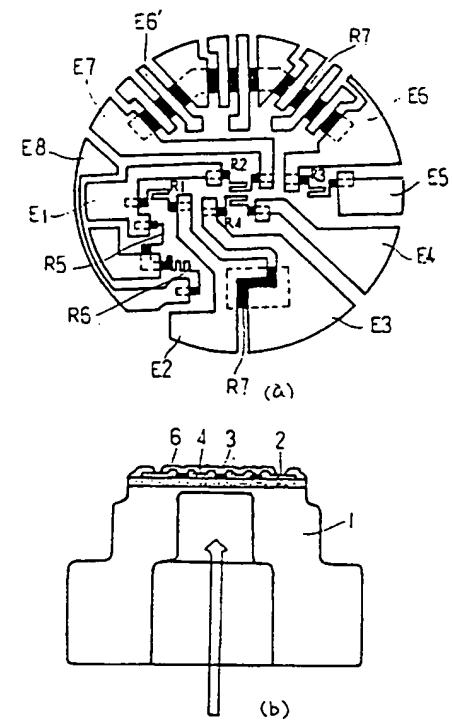
出願人 株式会社 小松製作所



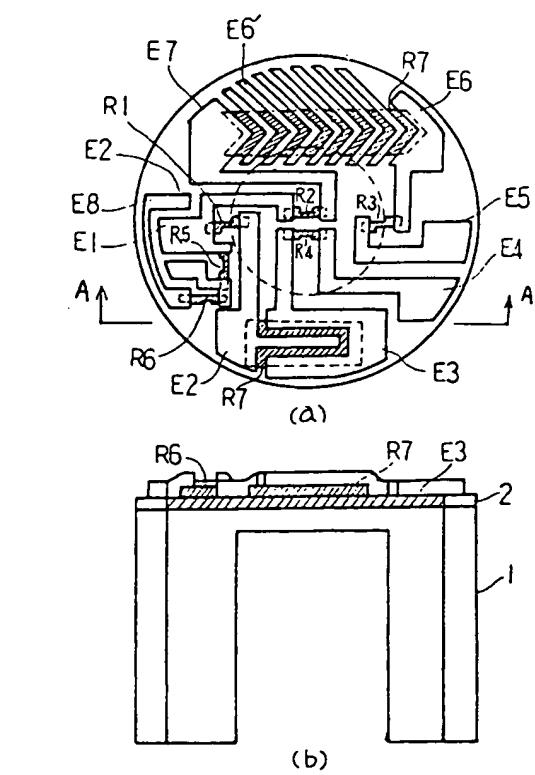
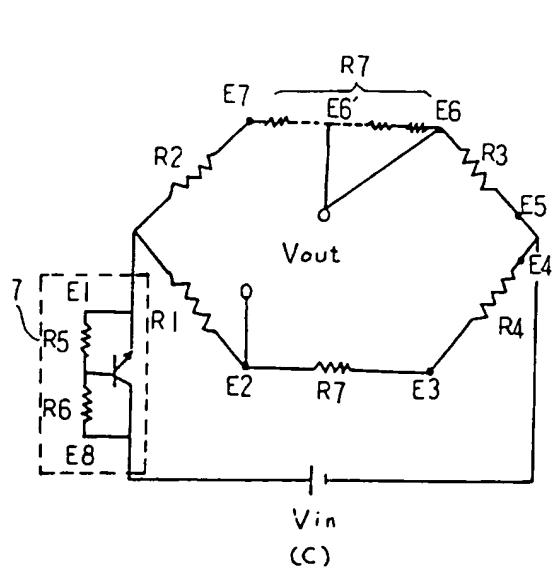
第1図



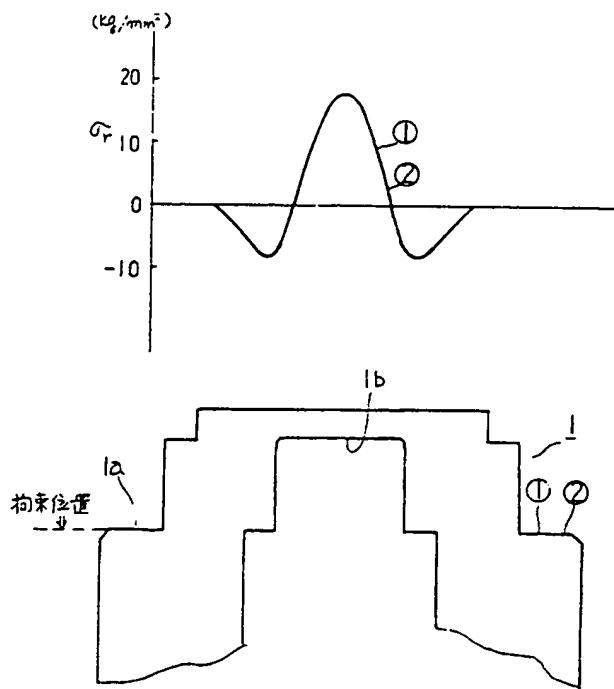
第2図



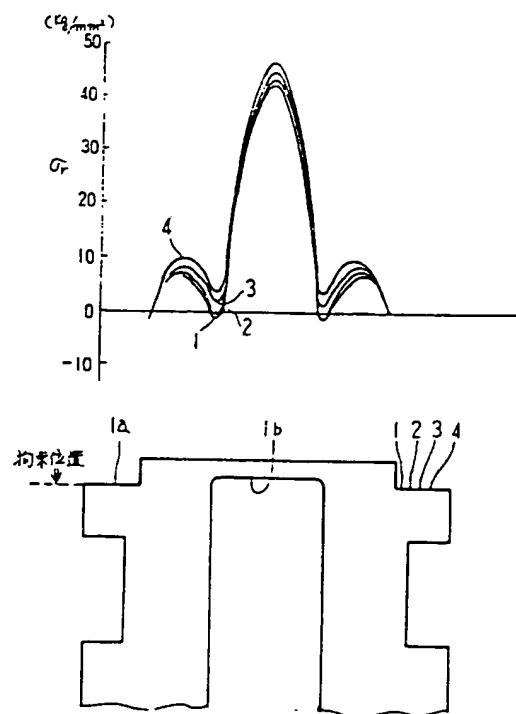
第4図



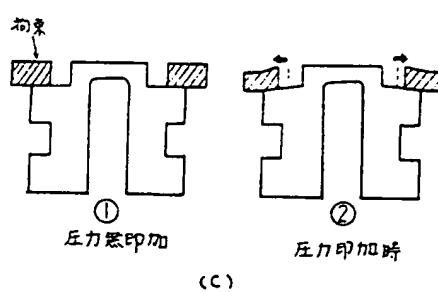
第3図



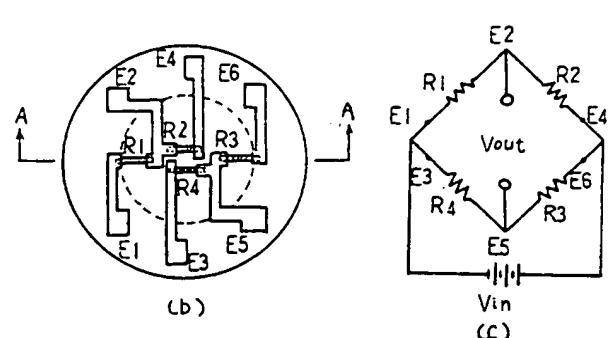
第5図 (a)



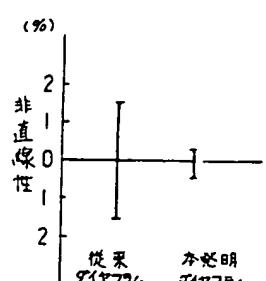
第5圖 (5)



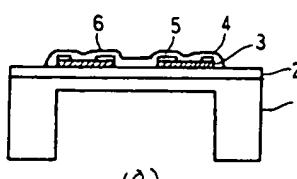
(C)



16

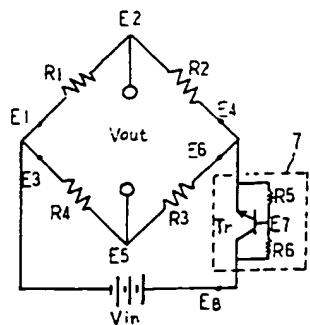


541

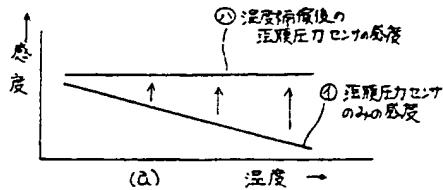


(a)

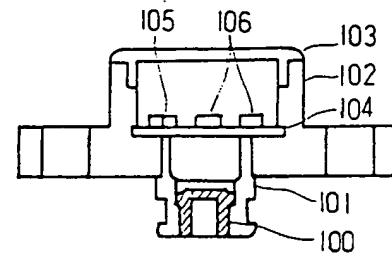
第6回



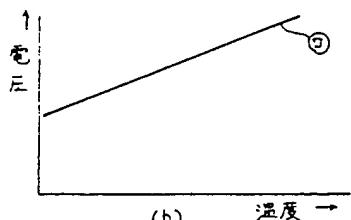
第7図



(a) 湿度 →



第9図



第8図